


Изменение № 3 ГОСТ 2 730—73 Единая система конструкторской документации
Обозначения условные графические в схемах Приборы полупроводниковые

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03 89 № 670

Дата введения 01 01 90

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение (СТ СЭВ 661—77) на (СТ СЭВ 661—88).

Пункт 2. Таблица 1 Графу «Обозначение» дополнить чертежами.

пункт 2. База с двумя выводами или 

пункт 11. Выводы полупроводниковых приборов, электрически не соединенные

с корпусом

или


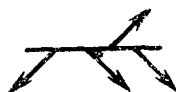


выводы полупроводниковых приборов, электрически соединенные с корпусом


или



пункт 2 Несколько эмиттеров, например, четыре *P*-эмиттера с *N*-областью изложить в новой редакции:



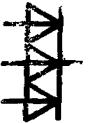

Наименование	Обозначение
несколько <i>P</i> -эмиттеров с <i>N</i> -областью	
несколько <i>N</i> -эмиттеров с <i>P</i> -областью	

Пункт 5 Таблицу 4 дополнить пунктом 9:

Наименование	Обозначение
9 Эффект Шоттки	

Пункт 6. Таблица 5. Пункт 6 изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 8а, 10:


(Продолжение см. с. 380)


Наименование	Обозначение
6. Варикап (диод емкостной)	 или 
8а. Модуль с несколькими одинаковыми диодами с общим катодным и самостоятельными анодными выводами	
10. Диод светоизлучающий	


графа «Обозначение». Для пункта 9 чертеж заменить новым:






Пункт 7. Таблица 6. Чертежи заменить новыми:




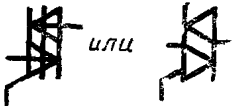
для пункта 2  ;

для пункта 5. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду  ;

пункт 3 дополнить чертежом: или  ;

пункты 6 — 8 изложить в новой редакции:

Наименование	Обозначение
6. Тиристор триодный выключаемый общее обозначение	
запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду	
запираемый в обратном направлении, с управлением по катоду	







Наименование	Обозначение
7. Тиристор триодный, проводящий в обратном направлении:	
общее обозначение	
с управлением по аноду	
с управлением по катоду	
8. Тиристор триодный симметричный (двунаправленный) — триак	

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Допускается обозначение тиристора с управлением по аноду изображать в виде продолжения соответствующей стороны треугольника».

Пункт 8. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

Таблица 7

Наименование	Обозначение
1. Транзистор	
а) типа <i>PNP</i>	
б) типа <i>NPN</i> с выводом от внутреннего экрана	
2. Транзистор типа <i>NPN</i> , коллектор соединен с корпусом	
3. Транзистор лавинный типа <i>NPN</i>	

Наименование	Обозначение
4. Транзистор однопереходный с <i>N</i> -базой	
5. Транзистор однопереходный с <i>P</i> -базой	
6. Транзистор двухбазовый типа <i>NPN</i>	
7. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIP</i> с выводом от <i>i</i> -области	
8. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIN</i> с выводом от <i>i</i> -области	
9. Транзистор многоэмиттерный типа <i>NPN</i>	

Примечание. При выполнении схем допускается:



а) выполнять обозначения транзисторов в зеркальном изображении, например,












б) изображать корпус транзистора.

Пункт 9. Таблицу 8 изложить в новой редакции:

Таблица 8








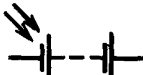
Наименование	Обозначение
1. Транзистор полевой с каналом типа <i>N</i>	
2. Транзистор полевой с каналом типа <i>P</i>	

Наименование	Обозначение
3. Транзистор полевой с изолированным затвором без вывода от подложки	
а) обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
б) обогащенного типа с <i>N</i> -каналом	
в) обедненного типа с <i>P</i> -каналом	
г) обедненного типа с <i>N</i> -каналом	
4. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с <i>N</i> -каналом, с внутренним соединением истока и подложки	
5. Транзистор полевой с изолированным затвором с выводом от подложки обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
6. Транзистор полевой с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>P</i> -каналом с выводом от подложки	
7. Транзистор полевой с затвором Шоттки	
8. Транзистор полевой с двумя затворами Шоттки	

Примечание. Допускается изображать корпус транзисторов.

Пункт 10 Таблицу 9 изложить в новой редакции


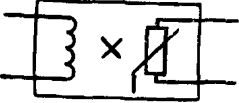
Таблица 9

Наименование	Обозначение
1. Фоторезистор	
а) общее обозначение	
б) дифференциальный	
2 Фотодиод	
3 Фототиристор	
4 Фототранзистор	
а) типа PNP	
б) типа NPN	
5 Фотоэлемент	
6. Фотобатарея	

Пункт 11. Таблица 10. Графа «Наименование». Пункт 4. Заменить слова: «Оптрон диодный с усилителем» на «Прибор оптоэлектронный с фотодиодом и усилителем»

(Продолжение см. с. 385)

Пункт 12. Таблицу 11 дополнить пунктами — 2, 3

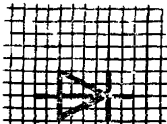
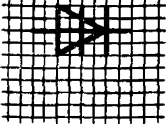
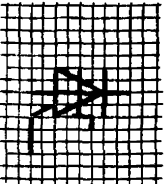
Наименование	Обозначение
2 Резистор магниточувствительный	
3 Магнитный разветвитель	

Пункт 15 изложить в новой редакции «Размеры условных графических обозначений полупроводниковых приборов указаны в приложении 1 Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений даны в приложении 2»

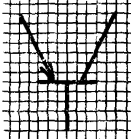
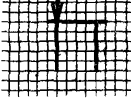
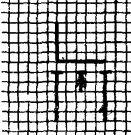
Стандарт дополнить приложением — 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений

Наименование	Обозначение
1 Диод	
2 Тиристор диодный	
3 Тиристор триодный	

(Продолжение см. с. 386)

Наименование	Обозначение
4. Транзистор	
5. Транзистор полевой	
6. Транзистор полевой с изолированным затвором	

(ИУС № 6 1989 г.)